

<<现代半导体器件物理>>

图书基本信息

书名：<<现代半导体器件物理>>

13位ISBN编号：9787030090591

10位ISBN编号：7030090594

出版时间：2002-7

出版时间：科学出版社

作者：(美) 施敏

页数：428

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<现代半导体器件物理>>

内容概要

本书是1981年版《半导体器件物理》的续编。

书中详细介绍了近20年来经典半导体器件的新增功能及新型半导体器件的物理机制。

全书共八章，内容涉及先进的双极晶体管和异质结器件，金属-半导体接触及各种场效应晶体管，功率器件、量子器件、热电子器件、微波器件、高速光子器件，以及太阳能电池等。

各章末除附有习题外还给出了尽可能多的参考文献。

书后附录提供了符号表、国际单位制基本单位、物理常数、晶格常数最新值，以及元素半导体，二元、三元化合物半导体和绝缘体的特征。

本书可作为应用物理、电子工程电机、材料科学领域大学本科生及研究生教材，也可供在半导体器件领域工作的科学家与工程师参考。

<<现代半导体器件物理>>

书籍目录

- 1, 双极晶体管
 - 2, 化合物半导体场效应晶体管
 - 3, MOSFET及其相关器件
 - 4, 功率器件
 - 5, 量子效应和热电子器件
 - 6, 有源微波二极管
 - 7, 高速光子器件
 - 8, 太阳电池
- 附录A 符号表
附录B 国际单位制 (SI单位)
附录C 单位词头
附录D 希腊字母
附录E 物理常数
附录F 300K的晶格常数
附录G 重要的元素和二元半导体性质
附录H Si和GaAs在300K的性质
附录I 3-V族三元化合物半导体的性质
附录J SiO和SiN在300K的性质
索引

<<现代半导体器件物理>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>